

Издательство «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» выпускает научно-технические журналы

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ежемесячный теоретический
и прикладной научно-
технический журнал

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В журнале освещаются современное состояние, тенденции и перспективы развития основных направлений в области разработки, производства и применения информационных технологий.

Ежемесячный
междисциплинарный
теоретический и прикладной
научно-технический журнал

НАНО- и МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА

В журнале освещаются современное состояние, тенденции и перспективы развития нано- и микросистемной техники, рассматриваются вопросы разработки и внедрения нано микросистем в различные области науки, технологии и производства.



Подписные индексы
по каталогам:
«Роспечать» – 72656;
«Пресса России» – 94033

Подписные индексы
по каталогам:
«Роспечать» – 79493;
«Пресса России» – 27849

Ежемесячный теоретический и прикладной научно-технический журнал МЕХАТРОНИКА, АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ

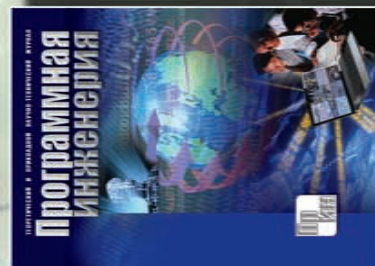
В журнале освещаются достижения в области мехатроники, интегрирующей механику, электронику, автоматику и информатику в целях совершенствования технологий производства и создания техники новых поколений. Рассматриваются актуальные проблемы теории и практики автоматического и автоматизированного управления техническими объектами и технологическими процессами в промышленности, энергетике и на транспорте.



Подписные индексы
по каталогам:
«Роспечать» – 79492;
«Пресса России» – 27848

Теоретический и прикладной научно-технический журнал ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

В журнале освещаются состояние и тенденции развития основных направлений индустрии программ-ного обеспечения, связанных с проектированием, конструированием, архитектурой, обеспечением качества и сопровождением жизненного цикла программного обеспечения, а также рассматриваются достижения в области создания и эксплуатации прикладных программно-информационных систем во всех областях человеческой деятельности.



Подписные индексы
по каталогам:
«Роспечать» – 22765;
«Пресса России» – 39795

Научно-практический и учебно-методический журнал БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В журнале освещаются достижения и перспективы в области исследований, обеспечения и совершенствования защиты человека от всех видов опасностей производственной и природной среды, их контроля, мониторинга, предотвращения, ликвидации последствий аварий и катастроф, образования в сфере безопасност-и жизнедеятельности.



Подписные индексы
по каталогам:
«Роспечать» – 79963;
«Пресса России» – 94032

Ежемесячный Научно-аналитический и производственный журнал ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

В журнале освещаются информационно- аналитические материалы по вопросам разработки, постановки на производство и использования горного оборудования на предприятиях горнопромышленных отраслей; обеспечения качества, надежности и безопасности электромеханических комплексов на горно-добывающих и перерабатывающих твердые полезные ископаемые предприятиях.



Подписные индексы
по каталогам:
«Роспечать» – 20134;
«Пресса России» – 39708

Адрес редакции журналов для авторов и подписчиков:
107076, Москва, Строминский пер., 4. Издательство "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ".
Тел.: (499) 269-55-10, 269-53-97. Факс: (499) 269-55-10. E-mail: antonov@novtex.ru

ISSN 1813-8586. Нано- и микросистемная техника. 2016. Том 18. № 11. 657–720. Индексы: 79493 («Роспечать»), 27849 («Пресса России»)

ISSN 1813-8586

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Биомикроэлектромеханические системы
- Микроэлектромеханические системы
- Микроэлектромеханические элементы датчиков и биочипы
- Молекулярная нанотехнология
- Нанороботы и биочипы
- Зондовая микроскопия
- Нанотехнологии

Том 18. № 11. 2016

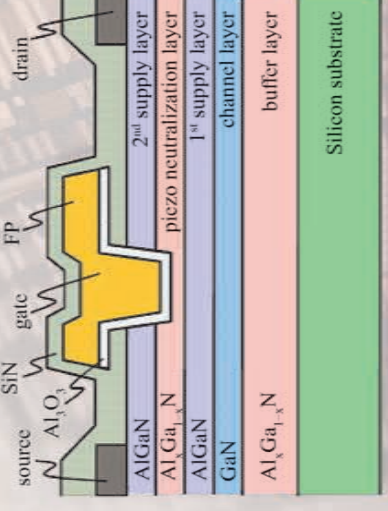
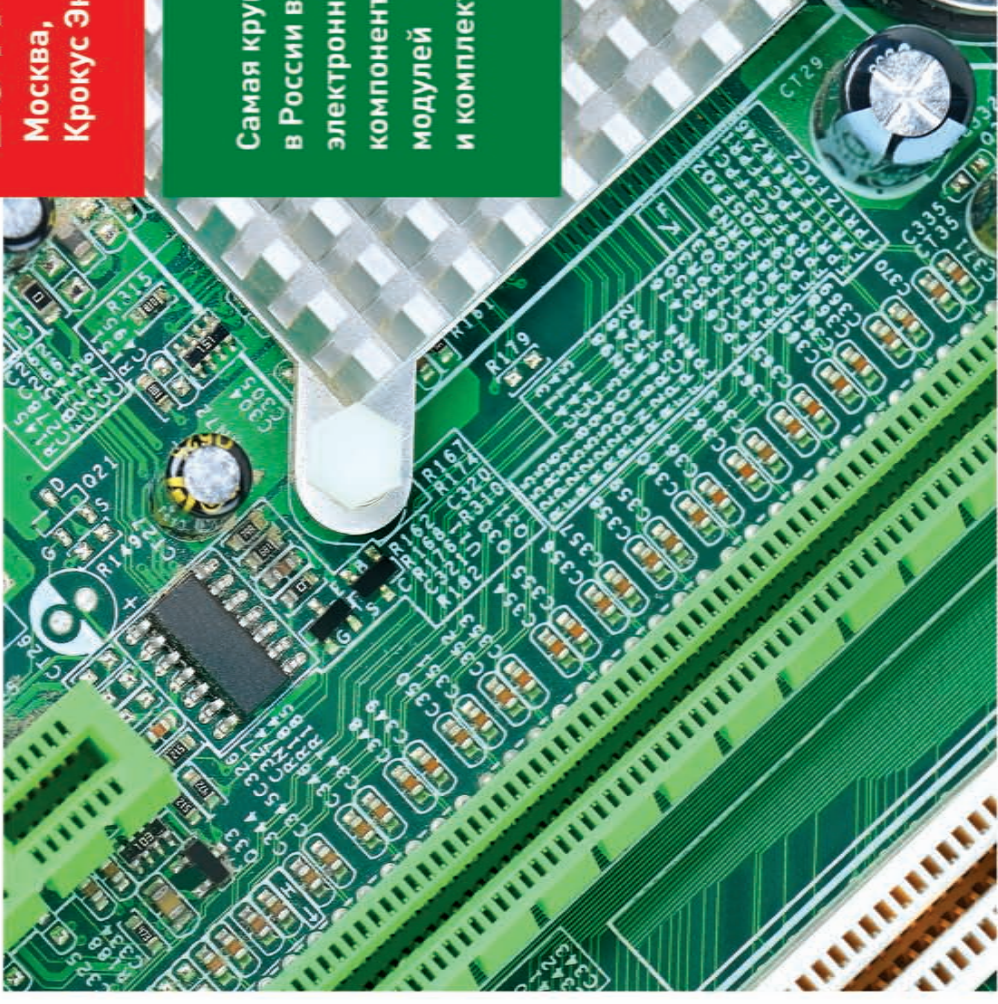


Рис. 4. Структура мощного транзистора фирмы NEC на GaN-on-Si
Fig. 4. Structure of a powerful transistor on GaN-on-Si from NEC Co

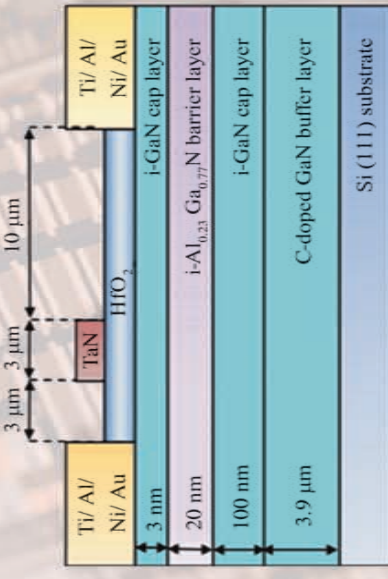


Рис. 5. Структура HEMT-транзистора на GaN-on-Si с подзатворным диэлектриком из HfO₂
Fig. 5. Structure of a HEMT transistor on GaN-on-Si with subgate dielectric from HfO₂

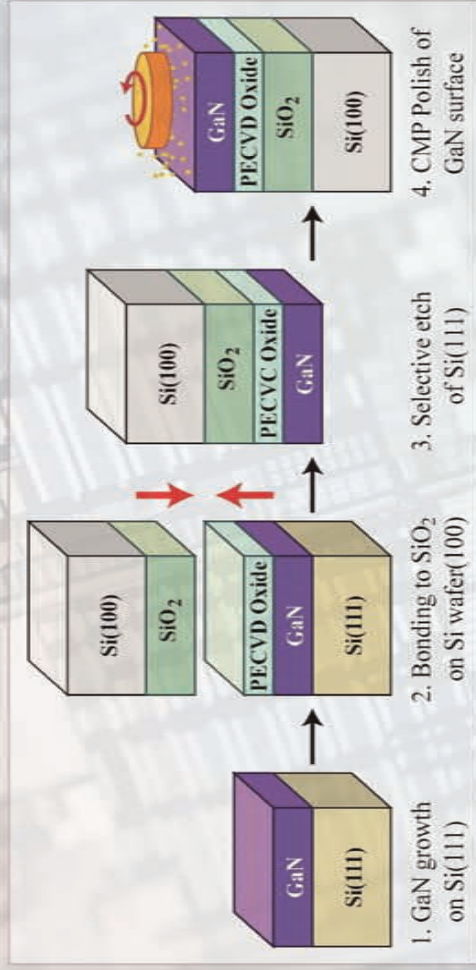


Рис. 7. Изготовление GaN светодиодов структуры GaN/Al на кремниевой подложке
Fig. 7. Manufacture of GaN light-emitting diodes of GaN/Al structure on a silicon substrate